

ми перегонки, жидкостной хроматографии или испарением. Производительность синтеза C_{60} при такой технологии составляет $\sim 1 \text{ г/ч}$; для C_{70} она на порядок ниже, однако получаемого кол-ва достаточно для исследований не только тонких пленок, но и поликристаллов, состоящих из молекул данного сорта. $\Phi.$ с более высоким числом C получают в меньших кол-вах. Наряду с замкнутыми сферич. и сфероидальными структурами при термич. распылении графита образуются протяжённые структуры — тубулы, построенные также на основе шестиугольных углеродных колец, характерных для графита. Они представляют собой спирально свёрнутые слои графита, длина таких трубок достигает неск. мк, а диаметр — неск. нм. Один из торцов закруглён и составляет шести- и пятиугольными кольцами C , др. торец обычно прикрепляется к стенке эксперим. камеры. $\Phi.$ образуются также в пламёнах разных углеводородов и при пиролизе смол. Имеются сообщения о присутствии $\Phi.$ в нек-рых природных минералах (напр., в шунгите).

Молекулы $\Phi.$ сохраняют форму при нагреве до темп-ры ок. 2000 К. Темп-ра плавления C_{60} ок. 1800 К. В твёрдом состоянии C_{60} представляет собой кристалл с плотноупакованной гексагональной или гранецентрированной кубич. структурой (в зависимости от условий получения кристалла). При темп-ре ниже 256 К происходит фазовый переход с образованием кубич. кристаллич. структуры. Плотность кристаллич. C_{60} при нормальных условиях $1,69 \text{ кг/дм}^3$, расстояния между центрами соседних молекул при этом составляют 1,00 нм. Кристаллич. C_{60} — полупроводник с шириной запрещённой зоны 1,5—1,9 эВ.

В 1991 были открыты сверхпроводящие свойства поликристаллич. C_{60} , легированного атомами щелочных металлов. В табл. приведены параметры сверхпроводящих соединений C_{60} , полученных при исследовании поликристаллич. образцов. Результаты исследований показали, что механизм сверхпроводимости в таких структурах основан на образовании куперовских пар в результате взаимодействия электронов с внутримолекулярными колебаниями в молекуле C_{60} .

Потенц. возможности использования $\Phi.$ и фуллеренсодержащих соединений основаны на их уникальных физ.-хим. свойствах. Фторированные $\Phi.$ могут стать основой для идеального твёрдого смазочного материала, пригодного для работы при сверхнизких темп-рах. Перспективно применение фуллереновых покрытий в качестве катализаторов при напылении искусств. алмазных покрытий из углеродной плазмы газового разряда. Использование в этой технологии многослойных покрытий C_{70} привело к увеличению скорости роста алмазной пленки на ~ 10 порядков.

Критическая температура T_c перехода в сверхпроводящее состояние и параметр кристаллической решётки a_0 для поликристаллических образцов соединений C_{60} с атомами щелочных металлов

Образец	$T_c, \text{ К}$	$a_0, \text{ нм}$
$RbCs_2C_{60}$	33	$1,4555 \pm 0,0007$
Rb_2CsC_{60}	31	$1,4431 \pm 0,0006$
Rb_3C_{60}	29	$1,4384 \pm 0,0010$
KRb_2C_{60}	27	$1,4324 \pm 0,0010$
K_2CsC_{60}	24	$1,4292 \pm 0,0010$
K_2RbC_{60}	23	$1,4243 \pm 0,0010$
K_3C_{60}	19	$1,4240 \pm 0,0006$
Na_2CsC_{60}	12	$1,4134 \pm 0,0006$
Li_2CsC_{60}	12	$1,4120 \pm 0,0021$
Na_2RbC_{60}	2,5	$1,4028 \pm 0,0011$
Na_2KC_{60}	2,5	$1,4025 \pm 0,0010$
Na_2CsC_{60}	12	4
C_{60}		$1,4161 \pm 0,0009$

Уникальные нелинейные оптич. свойства $\Phi.$ и их растворов открывают возможности их применения в качестве нелинейных оптич. элементов (удвоителей и утроителей частоты) в видимой области спектра, а также оптических затворов (пороговая интенсивность лазерного излучения,

соответствующая снижению прозрачности раствора C_{60} или C_{70} в бензole или толуоле на 2—3 порядка, составляет $\sim 10^7 \text{ Вт/см}^2$). Оптич. затворы на основе $\Phi.$ могут найти применение в оптич. устройствах обработки и передачи информации для защиты их датчиков и др. уязвимых элементов от интенсивного лазерного излучения.

Твёрдые $\Phi.$ с полупроводниковыми свойствами обладают фотопроводимостью в видимом диапазоне и могут использоваться в датчиках оптич. излучения слабой интенсивности и в преобразователях оптич. сигналов. Обсуждается возможность создания сверхпроводящих устройств на основе $\Phi.$, особенно $\Phi.$ с высоким числом атомов, т. к. для них ожидаемая темп-ра перехода в сверхпроводящее состояние лежит в диапазоне 60—100 К. Перспективы возможного использования углеродных микротрубок связывают с созданием на их основе систем записи, хранения, переработки и передачи информации.

Структура молекул $\Phi.$ позволяет рассматривать их как трёхмерный аналог ароматич. соединений. В хим. процессах $\Phi.$ проявляют себя как слабые окислители. Они легко присоединяют водород, галогены, свободные радикалы, щелочные металлы и их оксиды. Особый интерес представляет полученное металло содержащее соединение $C_{60}(OsO_4)L_2$ (где L — трет.-бутилперидин), обладающее ферромагн. свойствами, а также создание аналогичных соединений с др. металлами платиновой группы. Присоединение к $\Phi.$ металло содержащего органич. радикала уменьшает сродство молекулы $\Phi.$ к электрону, что изменяет её электрич. свойства и открывает возможность создания нового класса органических полупроводников с параметрами, изменяющимися в широком диапазоне.

Одно из перспективных направлений химии $\Phi.$ связано с возможностью внедрения внутрь полой сферич. или сфероидальной молекулы одного или неск. атомов и созданием, т. о., нового класса хим. соединений. Такие структуры (эндоэдралы) позволяют локализовать атомы с повыш. хим. активностью в строго определённой точке биол. объекта или элемента микроэлектроники. В настоящее время (1995) синтезировано значит. кол-во эндоэдральных структур, в к-рых в молекулы $\Phi.$ (C_{60} , C_{70} , C_{78} , C_{84} и др.) внедрено до 3 атомов мн. элементов (в т. ч. металлов).

Лит.: Елецкий А. В., Смирнов Б. М., Кластер C_{60} — новая форма углерода, «УФН», 1991, т. 161, в. 7, с. 173; их же, Фуллерены, там же, 1993, т. 163, в. 2, с. 33; Когоно H. W., Alla G. A. W., Baum S. P., C_{60} : Buckminsterfullerene, «Chem. Rev.», 1991, v. 91, p. 1213.

А. В. Елецкий

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ДЛИНА (элементарная длина) — гипотетич. универсальная постоянная размерности длины, определяющая пределы применимости фундам. физ. представлений — теории относительности, квантовой теории, принципа причинности. Через $\Phi.$ д. l выражаются масштабы областей пространства-времени и энергии-импульса (линейных размеров $x < l$, интервалов времени $t < l/c$, энергии $\mathcal{E} > \hbar c/l$), в к-рых можно ожидать новых явлений, не укладывающихся в рамки существующей физ. картины. Если бы это ожидание оправдалось, то предстояло бы ещё одно революционное преобразование физики, сопоставимое по своим последствиям с созданием теории относительности или квантовой теории. Соответственно $\Phi.$ д. вошла бы как существ. элемент в теорию элементарных частиц, играя роль третьей (после c и \hbar) фундам. размерной константы физики, ограничивающей пределы применимости старых представлений.

С помощью известных характерных физ. параметров можно построить ряд величин размерности длины, к-рые в разное время обсуждались как претенденты на роль $\Phi.$ д. Это — комптоновская длина волны электрона $\lambda_e \sim 10^{-11} \text{ см}$ (эл.-магн. взаимодействие), пиона $\lambda_\pi \sim 10^{-13} \text{ см}$ и нуклона $\lambda_N \sim 10^{-14} \text{ см}$ (сильное взаимодействие), характерная длина слабого взаимодействия $\sqrt{G_F/hc} \sim 10^{-16} \text{ см}$ (G_F — фермиевская константа слабого взаимодействия), гравитационная, или планковская длина $\sqrt{Gh/c^3} \sim 10^{-33} \text{ см}$ (G — гравитаци. постоянная). Отождествление $\Phi.$ д. с одной из перечисленных величин сыграло бы огромную роль для